

Интегральные микросхемы (ИМС) представляют собой последовательный компенсационный стабилизатор напряжения с фиксируемым выходным напряжением 12 В и выходным током 0.1 А, выполнены в корпусе типа КТ-26 (ТО-92), масса не более 0.3 г.

Назначение выводов КР1157ЕН12: 1 - выход; 2 - общий; 3 - вход.

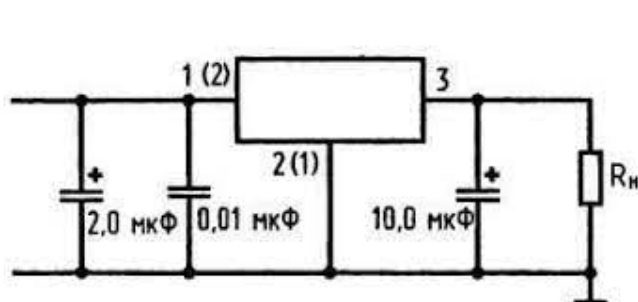


Схема включения

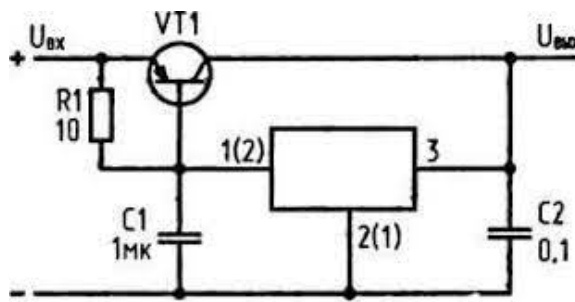


Схема включения с усилителем тока - транзистором КТ933Б

**Электрические параметры:** (при  $U_{вх} = 7.5...30$  В)

Выходное напряжение, В	+11.52 ... 12.48
Минимальное падение напряжения между входом и выходом, В, не менее	2
Ток потребления при $I_n = 0$ , мА, не более	5
Нестабильность по напряжению при $I_n = 5$ мА, %/В, не более	0.05
Нестабильность по току при $I_n = 100$ мА, %/мА, не более	0.001
Температурный коэффициент выходного напряжения при $I_n = 5$ мА, %/°С, не более	0.03

**Предельно допустимые режимы эксплуатации:**

Входное напряжение, В, не более	0 ... +30
Выходной ток, мА, не более	100
Рассеиваемая мощность, Вт, не более	0.5
Тепловое сопротивление кристалл-среда, °С/Вт, не более	250
Температура кристалла, °С, не более	+150
Температура окружающей среды, °С	-10 ... +70
Допустимое значение статического потенциала, кВ, не более	2
Минимальный фронт нарастания входного напряжения, мкс, не менее	30

**Рекомендации по применению:**

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °С. Скорость погружения (извлечения) выводов  $(25 \pm 2)$  мм/с, время выдержки не более 4 с, число допускаемых перепаек не более трех. Крепление микросхем к печатной плате производить методом распайки выводов на печатную плату. Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Величина емкости входного конденсатора должна быть не менее  $0.33 \mu\text{F} \pm 20\%$ , а расстояние от конденсатора до микросхемы не более 70 мм. Для исключения возможного возбуждения микросхемы рекомендуется использование танталовых блокировочных конденсаторов.

При монтаже в схему допускается одноразовый изгиб выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса под углом 90 °С с радиусом закругления не менее 1.5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус.

Рекомендуется эксплуатировать микросхемы при температуре кристалла ниже максимального значения, поскольку ее уменьшение позволяет увеличить срок службы микросхемы.

Для предотвращения электрического повреждения схем при положительных выбросах напряжения на выводе или инверсном включении, рекомендуется устанавливать защитный диод между входом и выходом.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: параллельное включение ИМС, подача на вход или выход ИС напряжений отрицательной полярности, нахождение ИМС в режиме КЗ более 30-ти минут.**